XMCD 測定による Ni_xFe_{4-x}N(x = 1, 3)薄膜中の 3d 元素の優先占有サイトの評価

Preferred site occupation for 3*d* atoms in $Ni_xFe_{4-x}N(x = 1, 3)$ films revealed by XMCD

筑波大数理 1,東北大金研 2,東北大 CSRN3,原子力機構 4,広島大理 5

^O高田郁弥 ¹, 伊藤啓太 ^{2,3}, 都甲薫 ¹, 竹田幸治 ⁴, 斎藤祐児 ⁴, 高梨弘毅 ^{2,3}, 木村昭夫 ⁵, 末益崇 ¹

Univ. of Tsukuba¹, IMR, Tohoku Univ.², CSRN, Tohoku Univ.³, JAEA⁴, Hiroshima Univ.⁵

°F. Takata¹, K. Ito^{2,3}, K. Toko¹, Y. Takeda⁴, Y. Saitoh⁴, K. Takanashi^{2,3}, A. Kimura⁵, and T. Suemasu¹ E-mail: bk1413075@s.bk.tsukuba.ac.jp

【背景】 逆ペロブスカイト型強磁性窒化物(図 1)の一つである Ni_xFe_{4-x}N は、理論計算から Ni₃FeN で大きな負の状態密度のスピン分極(*P*)が期待できるが、*P*の値は 3*d* 元素の占有サイトに大きく 影響される¹⁾。我々はこれまでに X 線磁気円二色性(XMCD)測定により類型の Co₃FeN 薄膜の電子 構造を評価し、Co 原子と Fe 原子がサイトをランダムに占有することを明らかにした^{2,3)}。本研究 では、XMCD 測定により Ni_xFe_{4-x}N(x = 1, 3)薄膜中の 3*d* 元素の優先占有サイトを評価した。

【実験方法】分子線エピタキシー法により、SrTiO₃(001)基板上へ Al(3 nm)/NiFe₃N(50 nm)、Al(3 nm)/Ni₃FeN(50 nm)をエピタキシャル成長し測定に供した。XMCD 測定は全電子収量法によりおこない、外部磁場±4Tを試料面直方向に印加して温度 100 K で測定した。

【結果・考察】図2に、(a)NiFe₃N、(b)Ni₃FeN薄膜のNi、Fe-L_{2,3}吸収端におけるX線吸収スペクトルを示す。Ni₃FeNではNi、Fe-L_{2,3}吸収端ピークの高エネルギー側に肩構造(図中矢印)が観測されたのに対し、NiFe₃NではFe-L_{2,3}吸収端のみで観測された。同様の肩構造はFe₄Nでも観測されており、面心(II)サイトのFe 3*d*とN2*p*の電子軌道混成に起因する³⁾。Ni_xFe_{4.x}Nでも同様の起源で 肩構造が現れたと考えられ、NiFe₃NではNi 3*d*とN2*p*の電子軌道混成が無く、Ni原子は角(I)サイトを優先占有していると考えられる。また、磁気光学総和則から算出したNiFe₃N薄膜中のNi 原子のスピン磁気モーメントの大きさは、Ni原子がIサイトを占有した場合の理論値と近く、Ni

【**謝辞】**XMCD 測定は SPring-8 BL23SU (課題 No. 2017A3842)にておこなった。本研究の一部は、東北大学スピントロニクス学術連携研究教育センター(CSRN)の支援を受けた。

1) F. Takata *et al.*, J. Appl. Phys. **120**, 083907 (2016). 2) K. Ito *et al.*, Appl. Phys. Lett. **103**, 232403 (2013). 3) K. Ito *et al.*, J. Appl. Phys. **117**, 193906 (2015). 4) F. Li *et al.*, Appl. Phys. Lett. **66**, 2343 (1995).



Fig. 1 Anti-perovskite type crystal structure.



Fig. 2 X-ray absorption spectroscopy (XAS) spectra in (a)NiFe₃N and (b)Ni₃FeN films at Ni and Fe- $L_{2,3}$ edges.